

	<p>SQD40061EL_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQD40061EL_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CHAN 40V</p> <p>Datenblätter:  SQD40061EL_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQD40061EL_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CHAN 40V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.1 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	SQD40061EL_GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	280nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 40V 100A (Tc) 107W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

SQD40061EL_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQD40061EL_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQD40061EL_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQD40061EL_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQD35N05-26L-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p>	 <p>SQD40030E_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V TO252AA</p>	 <p>SQD40030E_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 40V TO252AA</p>	 <p>SQD400A60 SANREX IGBT Modules</p>
 <p>SQD40031EL_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V</p>	 <p>SQD40081EL_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 40V TO252</p>	 <p>SQD400A60S IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p>SQD35N05-26L-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQD40061EL_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQD40061EL_GE3 Datenblatt	SQD40061EL_GE3-Datenblätter	SQD40061EL_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQD40061EL_GE3
SQD40061EL_GE3 Electronic	SQD40061EL_GE3-Komponenten	SQD40061EL_GE3-Verteiler	SQD40061EL_GE3-Bild	SQD40061EL_GE3-Teil
SQD40061EL_GE3 Preis	SQD40061EL_GE3 Hersteller	SQD40061EL_GE3 Bild	SQD40061EL_GE3 Aktie	SQD40061EL_GE3 Inventar
SQD40061EL_GE3 Neu	SQD40061EL_GE3 Original	SQD40061EL_GE3 garantiert	SQD40061EL_GE3 RFQ	SQD40061EL_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited